

ТРАНЗИСТОРЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ СВЧ
HIGH-POWER MICROWAVE TRANSISTORS

KT942B

Транзисторы KT942B предназначены для работы в оконечных каскадах усилителей мощности аппаратуры широкого применения.

Si-n-p-n-EP

The KT942B transistors are designed for use in the output stages of power amplifiers in a wide range of applications.

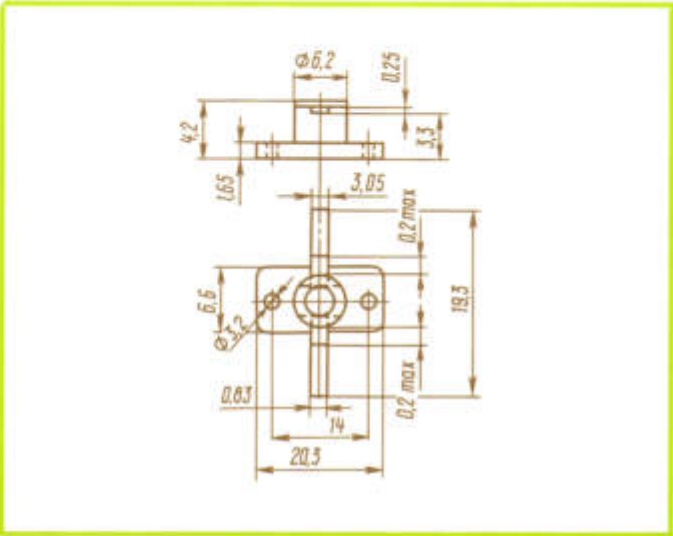
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{case} = -60...+100^{\circ}C$
MAXIMUM RATINGS

$U_{CB\ max}, (t_{case} \leq 25^{\circ}C), V$	45
$U_{EB\ max}, V$	3,5
$I_C\ max, A$	1,5
$I_{CM\ max}, (t_p \leq 10\ \mu s, Q > 100), A$	3
$I_B\ max, A$	0,5
$P_C\ max, (t_{case} \leq 25^{\circ}C), W$	25
$t_j\ max, ^{\circ}C$	200

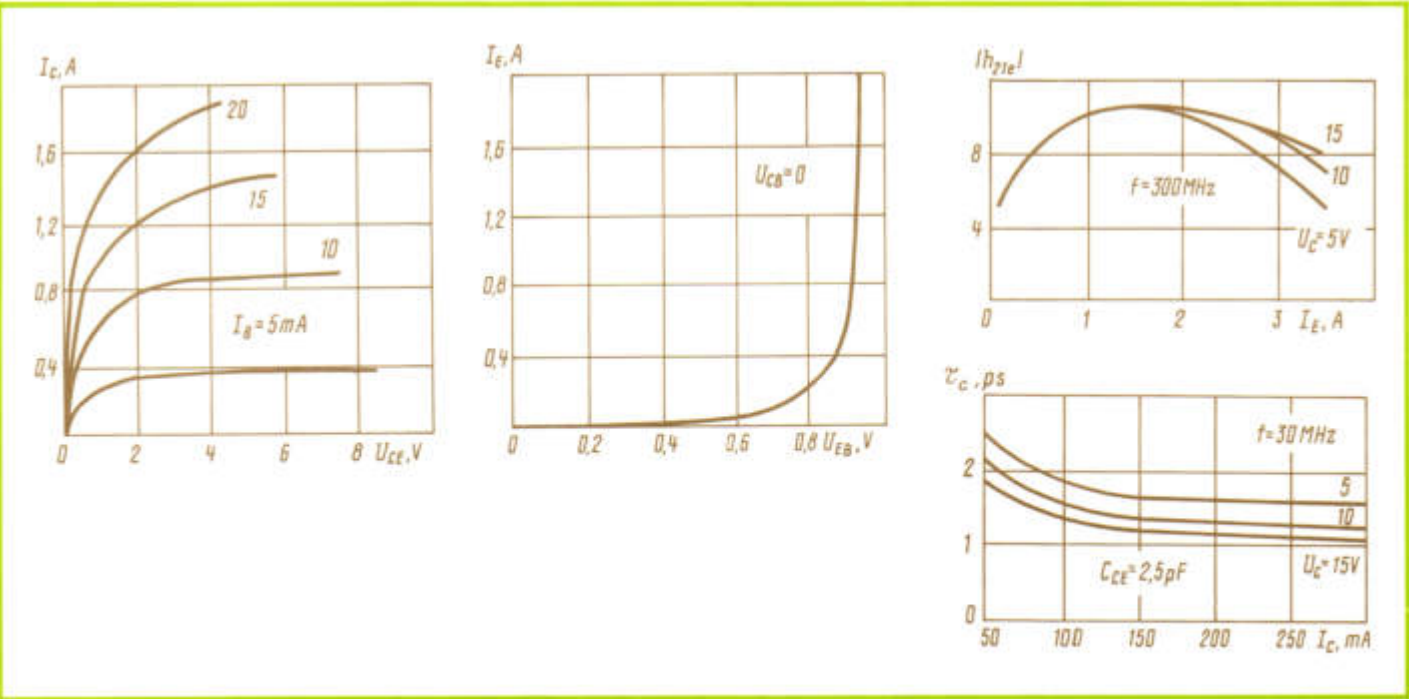
*При $t_{case} \geq 25^{\circ}C \Rightarrow P_{C\ max} = 25 - \frac{t_{case} - 25}{7}$

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	KT942B	Режимы Conditions
1	2	3
I_{CBO}, mA	≤ 20	$U_{CB} = 45\ V$
I_{EBO}, mA	≤ 10	$U_{EB} = 3,5\ V$
$ h_{21e} $	$\geq 6,5$	$U_{CB} = 10\ V$ $I_E = 1,2\ A$ $f = 300\ MHz$



1	2	3
τ_c, ps	≥ 3	$U_{CB} = 10\ V$ $I_E = 150\ mA$ $f = 30\ MHz$
C_c, pF	≤ 25	$U_{CB} = 28\ V$ $f = 10\ MHz$
P_{out}, W	≥ 9	$U_{CB} = 28\ V$ $P_{in} = 4\ W$ $f = 2000\ MHz$
$\eta_{C}, \%$	≥ 25	$U_{CB} = 28\ V$ $P_{in} = 4\ W$ $f = 2000\ MHz$
*Медианное значение. Mean value.		



KT942B

